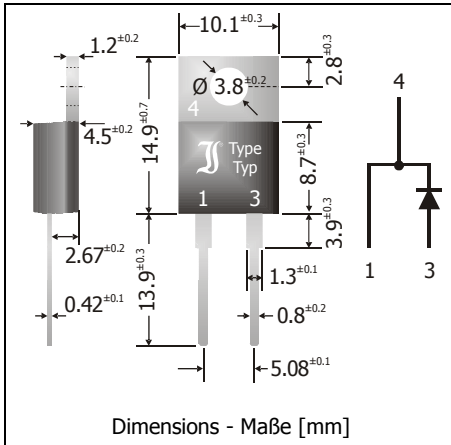


### MBR10100

#### High Temperature Schottky Rectifier Diodes – Single Diode Hochtemperatur Schottky-Gleichrichterdiode – Einzeldiode

Version 2015-01-14



- Nominal current / Nennstrom: 10 A
- Repetitive peak reverse voltage / Periodische Spitzensperrspannung: 100 V
- Plastic case – Kunststoffgehäuse: TO-220AC
- Weight approx. / Gewicht ca.: 1.8 g
- Plastic material has UL classification 94V-0 / Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
- Standard packaging in tubes / Standard Lieferform in Stangen



#### Maximum ratings and Characteristics

#### Grenz- und Kennwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]	Forward voltage Durchlass-Spannung $V_F$ [V] <sup>1)</sup>	
			$I_F = 5$ A	$I_F = 10$ A
MBR10100	100	100	tbd	< 0.8

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 125^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	10 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	$I_{FRM}$	30 A <sup>2)</sup>
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	SBT1090... $T_A = 25^\circ\text{C}$ SBT10100	$I_{FSM}$	135/150 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	80 A <sup>2</sup> s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	-50...+175°C -50...+175°C

1  $T_j = 25^\circ\text{C}$

2 Max. temperature of the case  $T_C = 100^\circ\text{C}$  – Max. Temperatur des Gehäuses  $T_C = 100^\circ\text{C}$

**Characteristics**

**Kennwerte**

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	$I_R$ $I_R$	< 100 $\mu\text{A}$ typ. 5 mA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse	$R_{thC}$			< 2 K/W

